

太陽風多価イオンの電荷交換反応

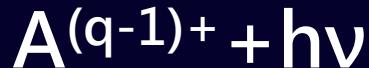
石田卓也¹, 神田拓真¹, 島谷紘史¹, 赤松弘規¹, 榎崇利¹,
石崎欣尚¹, 江副祐一郎¹, 大橋隆哉¹, 大橋隼人²,
篠崎慶亮³, 満田和久⁴, L. Liu⁵, J. Wang⁵, 田沼肇¹

¹首都大理工, ²電通大レーザー, ³ARD/JAXA, ⁴ISAS/JAXA, ⁵IAPCM/China



研究背景

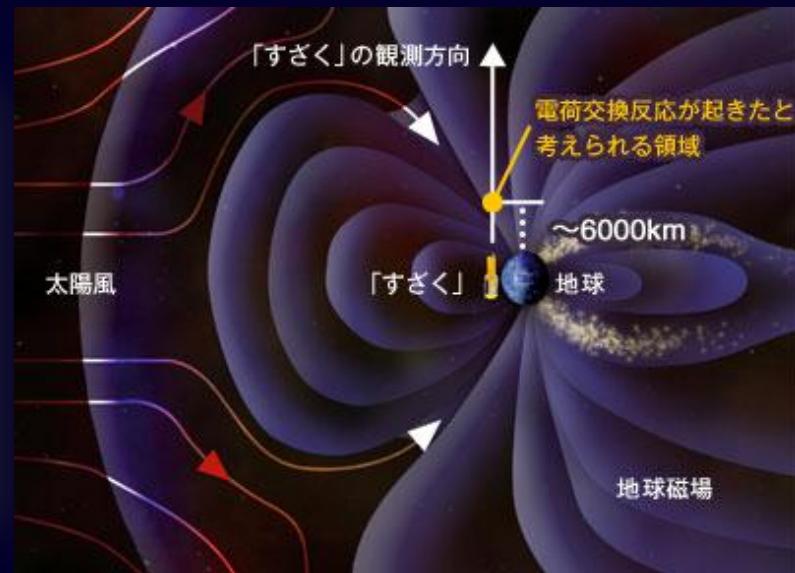
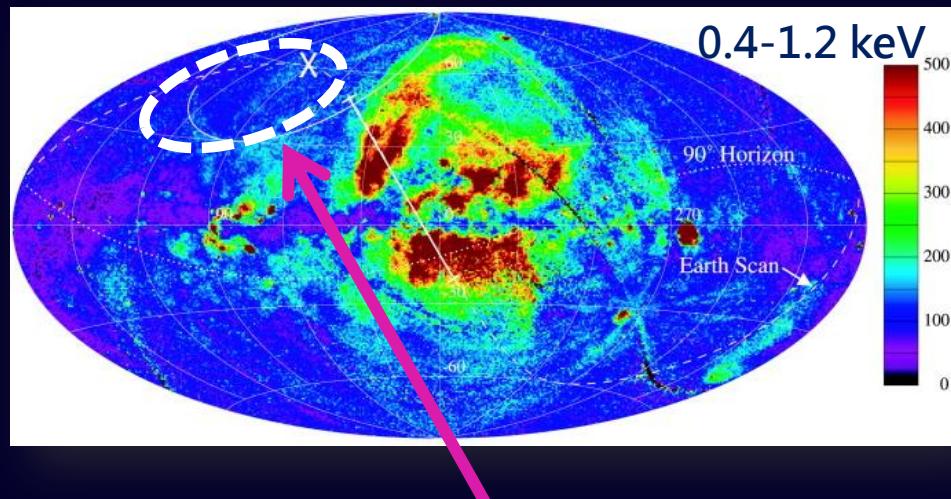
太陽風と太陽系内中性物質との衝突による電荷交換反応
Solar Wind Charge Exchange (SWCX)



$$A = C, O, Ne\dots$$

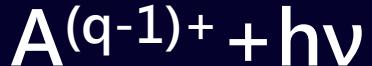
$$B = H, He$$

ROSAT衛星による軟X線全天マップ
 (Snowden et al., 1994)



研究背景

太陽風と太陽系内中性物質との衝突による電荷交換反応
Solar Wind Charge Exchange (SWCX)



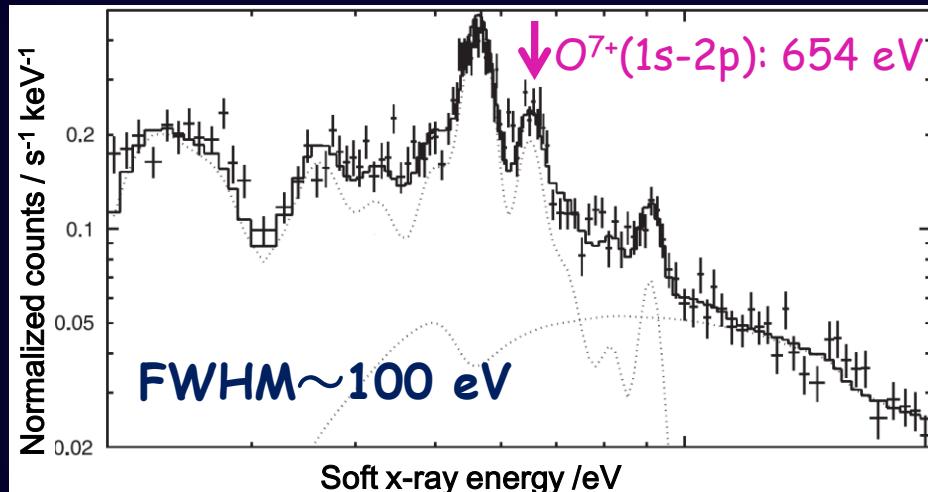
$$A = C, O, Ne\dots$$

$$B = H, He$$

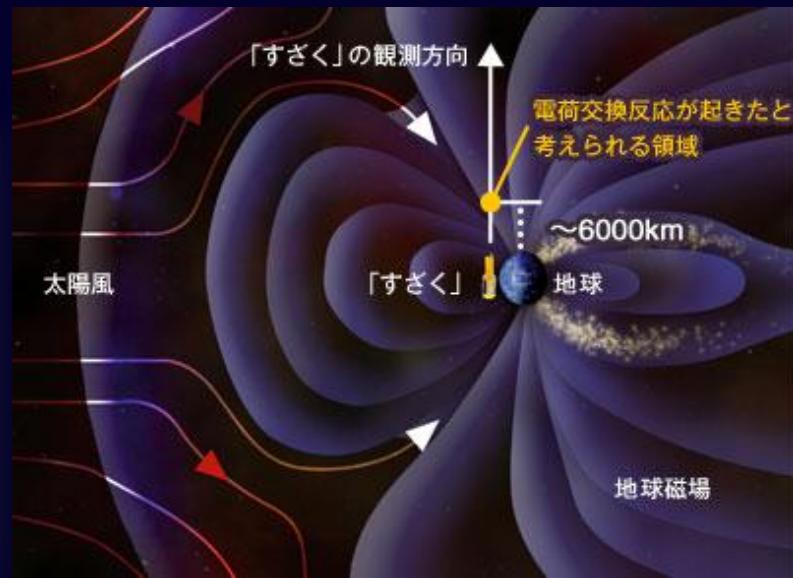
すざく衛星によるスペクトル

(R. Fujimoto et al., 2007)

↓ $O^{6+}(1s^2-1s2p)$: 574 eV
 ↓ $O^{7+}(1s-2p)$: 654 eV

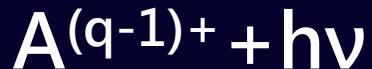


構造分離が不可 → 高分解能測定が必要
 発光断面積データの必要性



研究背景

太陽風と太陽系内中性物質との衝突による電荷交換反応
Solar Wind Charge Exchange (SWCX)

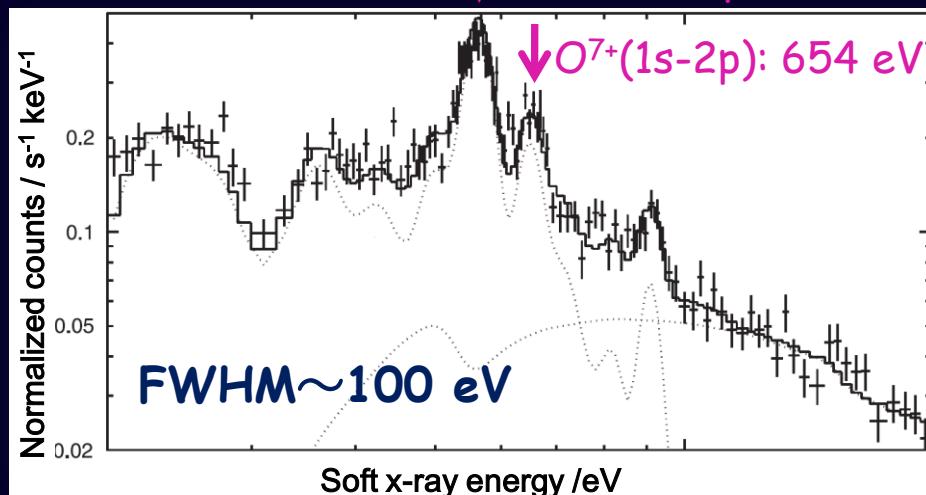


$$A = C, O, Ne\dots$$

$$B = H, He$$

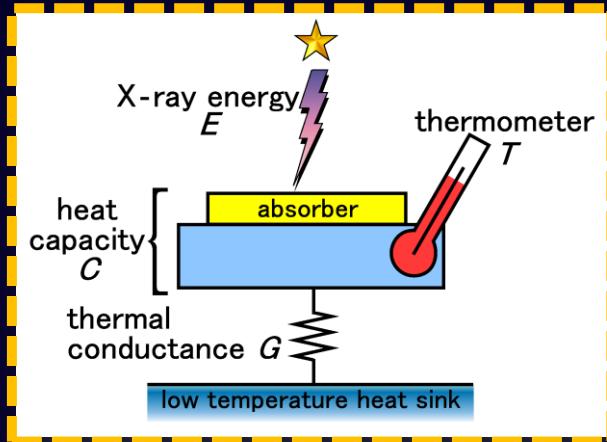
すぐく衛星によるスペクトル
(R. Fujimoto et al., 2007)

↓ $O^{6+}(1s^2-1s2p)$: 574 eV



構造分離が不可→高分解能測定が必要
発光断面積データの必要性

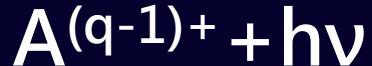
TESカロリメータ



FWHM < 10 eV

研究背景

太陽風と太陽系内中性物質との衝突による電荷交換反応
Solar Wind Charge Exchange (SWCX)

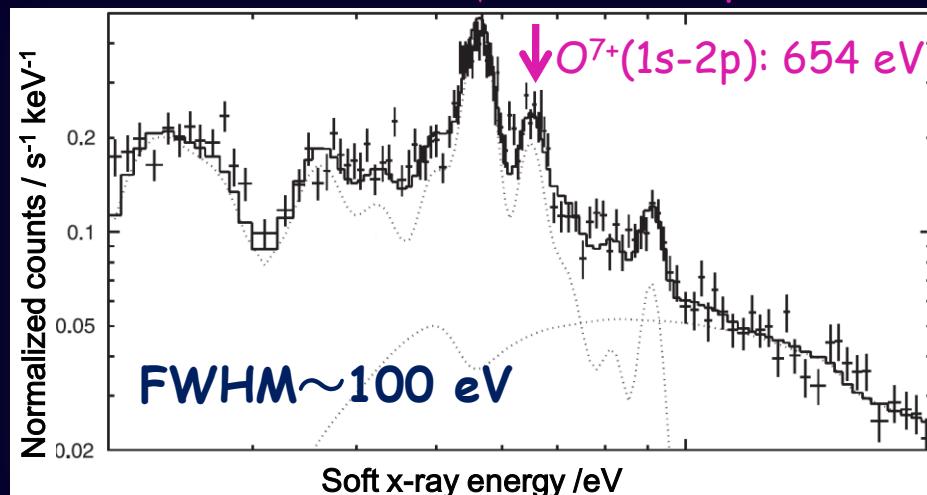


$$A = C, O, Ne\dots$$

$$B = H, He$$

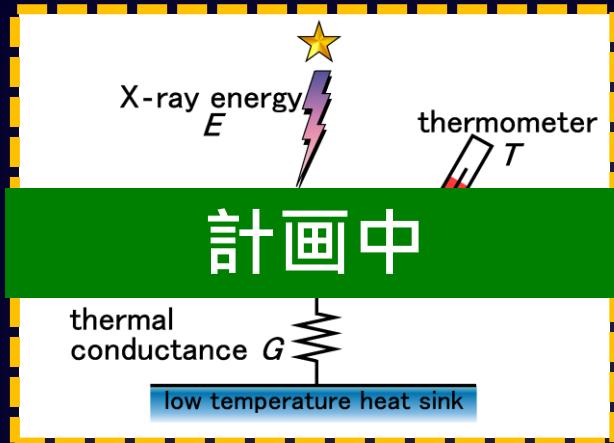
すぐく衛星によるスペクトル
(R. Fujimoto et al., 2007)

↓ $O^{6+}(1s^2-1s2p)$: 574 eV



構造分離が不可→高分解能測定が必要
発光断面積データの必要性

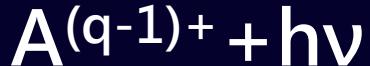
TESカロリメータ



FWHM < 10 eV

研究背景

太陽風と太陽系内中性物質との衝突による電荷交換反応
Solar Wind Charge Exchange (SWCX)



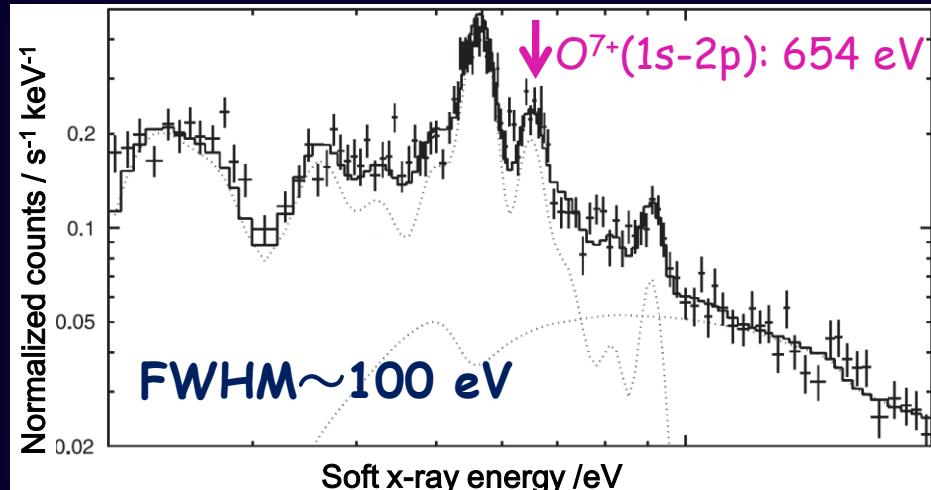
$A = C, O, Ne\dots$

$B = H, He$

すぐく衛星によるスペクトル

(R. Fujimoto et al., 2007)

↓ $O^{6+}(1s^2-1s2p): 574$ eV
 ↓ $O^{7+}(1s-2p): 654$ eV



構造分離が不可→高分解能測定が必要
 発光断面積データの必要性

Si(Li)半導体検出器

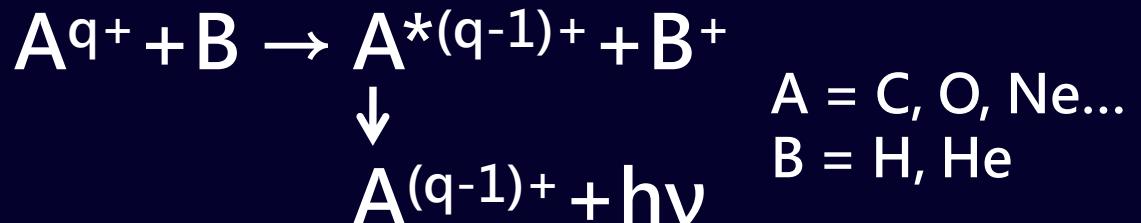
160 eV@5.9 keV



研究背景

太陽風と太陽系内中性物質との衝突による電荷交換反応

Solar Wind Charge Exchange (SWCX)

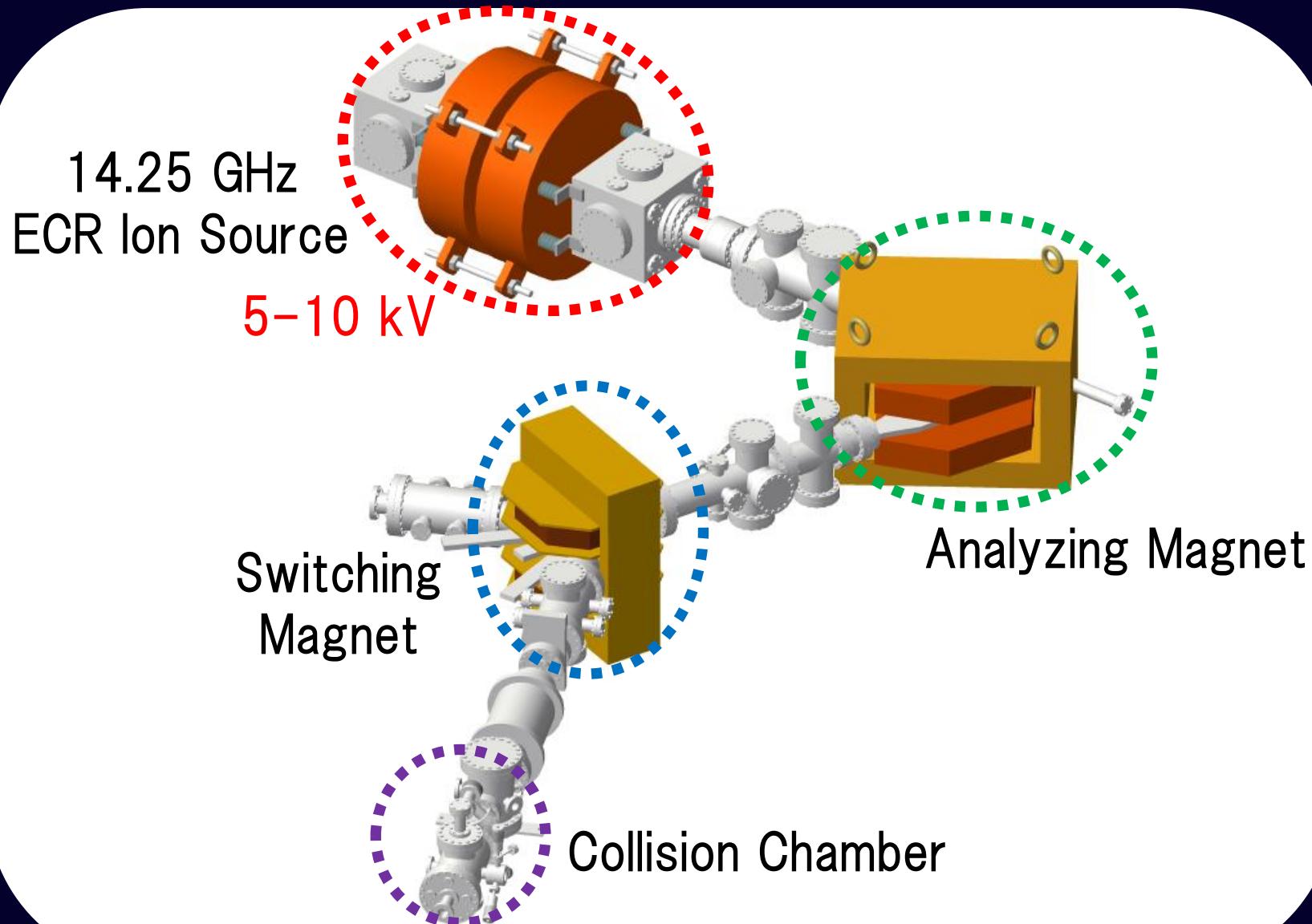


$$\begin{array}{l} A = C^{5+}, O^{7+} \\ B = H_2, He, CH_4 \end{array}$$

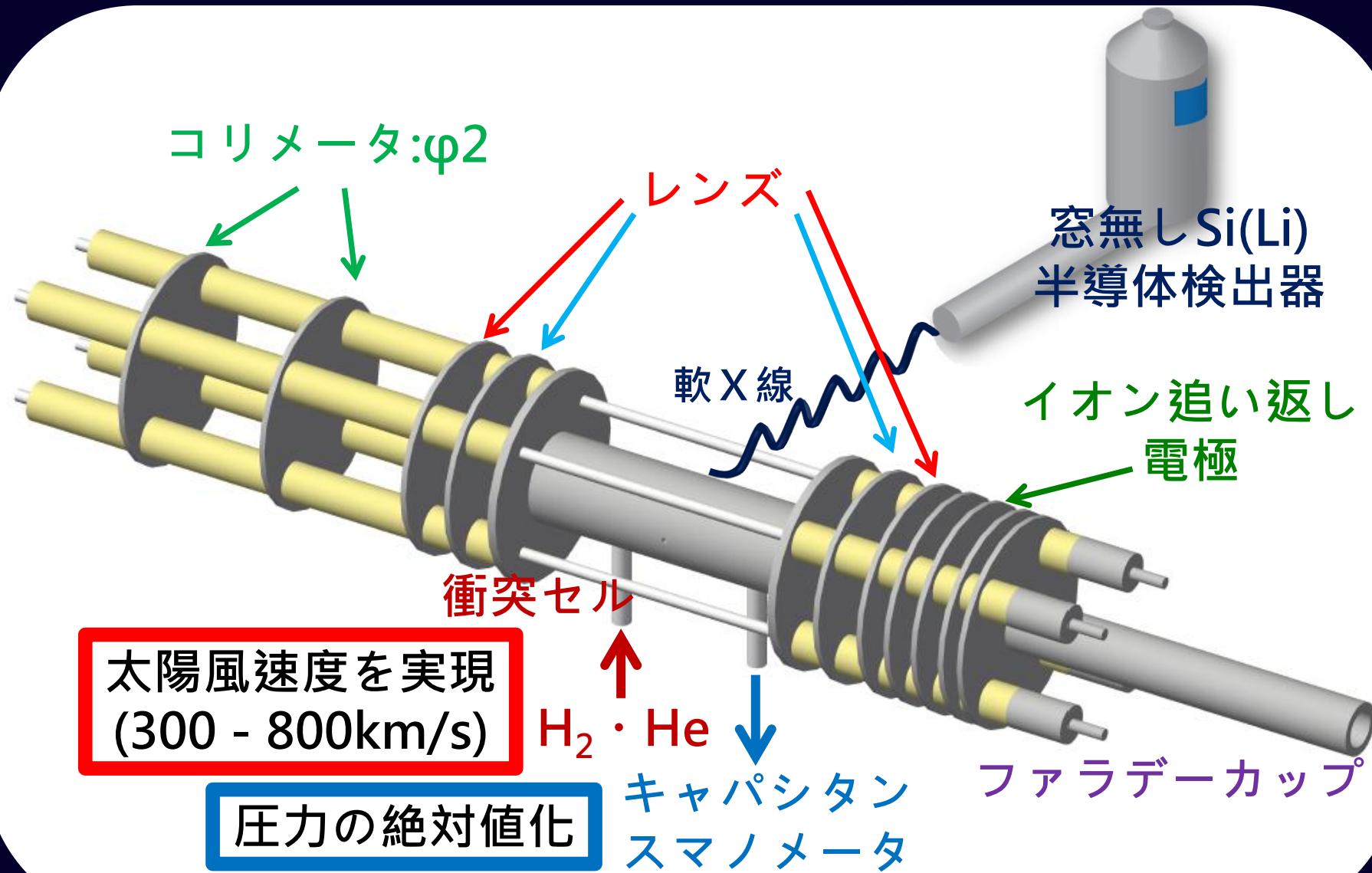
- 1電子捕獲断面積
- 等方散乱を仮定した発光断面積



実験装置



実験装置



減衰法による1電子捕獲断面積

$$\frac{dI}{dx} = -(\sigma n) I \quad I = I_0 \exp(-\sigma nl)$$

1回衝突条件 $\sigma nl \ll 1$

$$I \approx I_0(1 - \sigma nl)$$

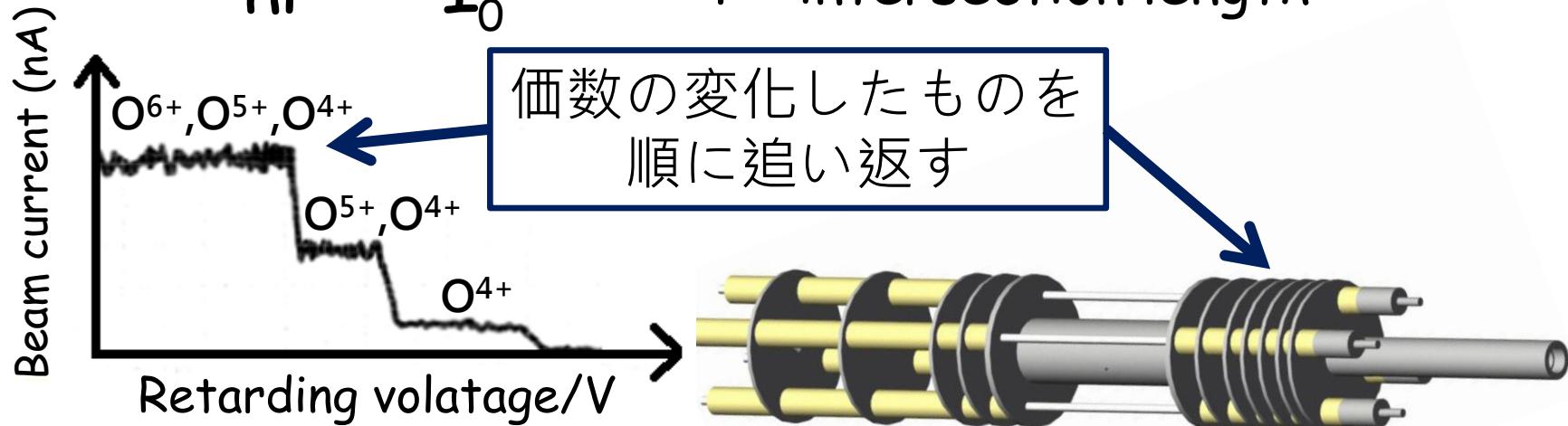
I : ion current

σ : cross section

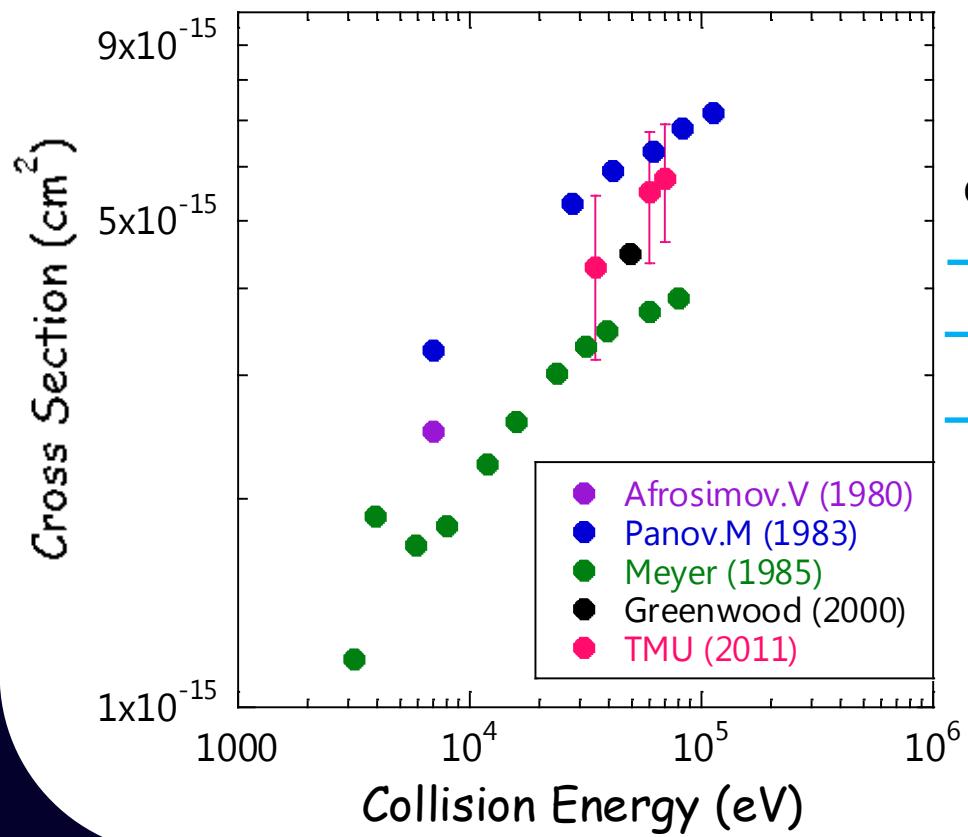
n : number density of target gas

l : intersection length

$$\sigma = \frac{1}{nl} \left(1 - \frac{I}{I_0} \right)$$



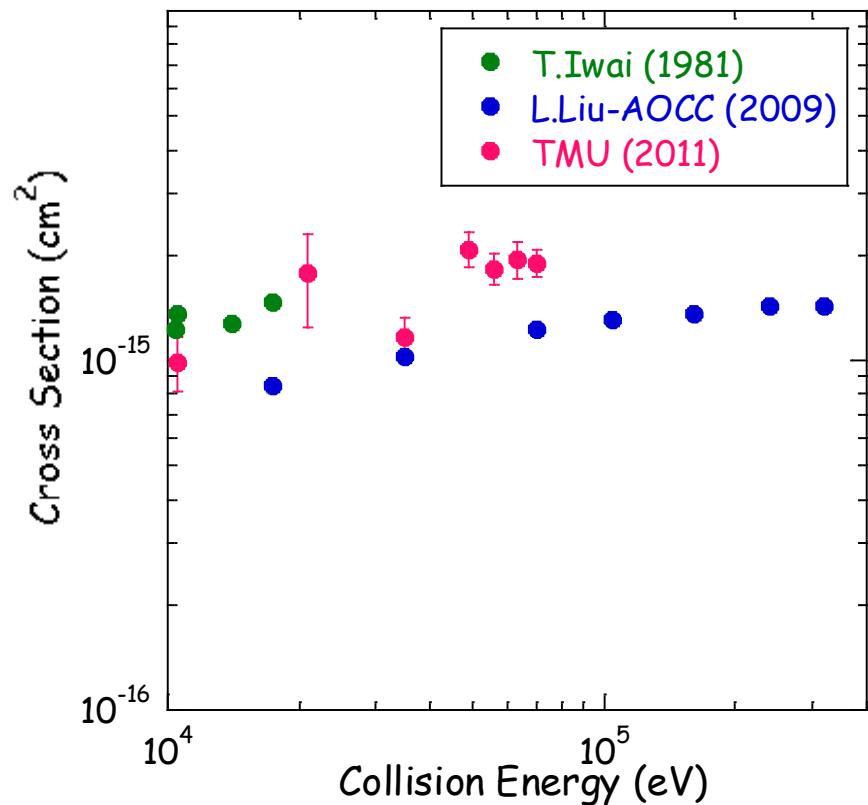
減衰法による1電子捕獲断面積



Collision Energy (keV)	Cross Section (cm^2)	Velocity (km/s)	error (%)
70	5.79×10^{-15}	919	19
60	5.53×10^{-15}	647	21
35	4.31×10^{-15}	650	27

減衰法による1電子捕獲断面積

O^{7+} -He

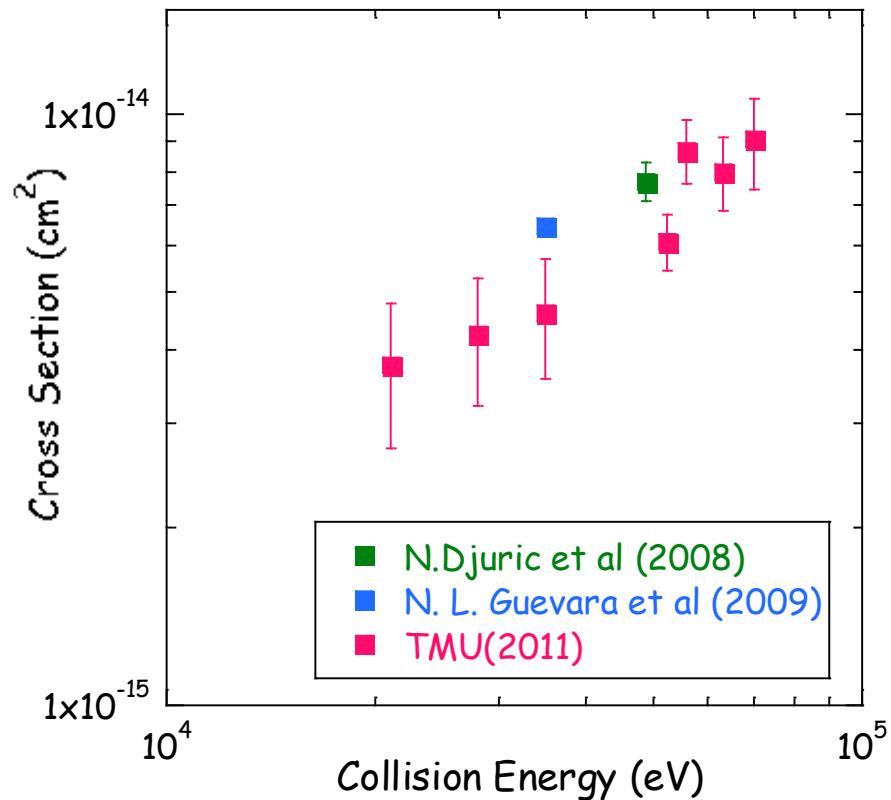


Collision Energy (keV)	Cross Section (cm ²)	Velocity (km/s)	error (%)
70	1.90×10^{-15}	919	9
63	1.95×10^{-15}	872	12
56	1.83×10^{-15}	822	11
49	2.08×10^{-15}	769	11
35	1.16×10^{-15}	650	14
21	1.77×10^{-15}	503	30
10.5	9.92×10^{-16}	356	18

減衰法による1電子捕獲断面積



IP: H=CH₄=13.6 eV

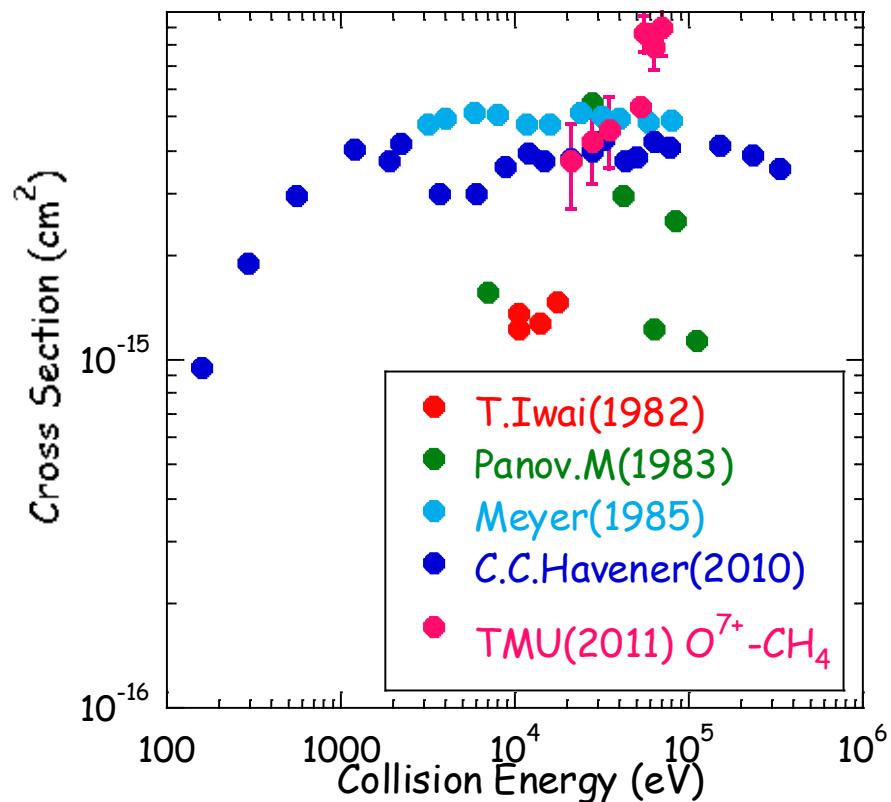


Collision Energy (keV)	Cross Section (cm^2)	Velocity (km/s)	error (%)
70	9.04×10^{-15}	919	17
63	7.99×10^{-15}	872	14
56	8.69×10^{-15}	822	12
52.5	6.09×10^{-15}	796	11
35	4.61×10^{-15}	650	23
28	4.24×10^{-15}	581	24
21	3.75×10^{-16}	503	28

減衰法による1電子捕獲断面積

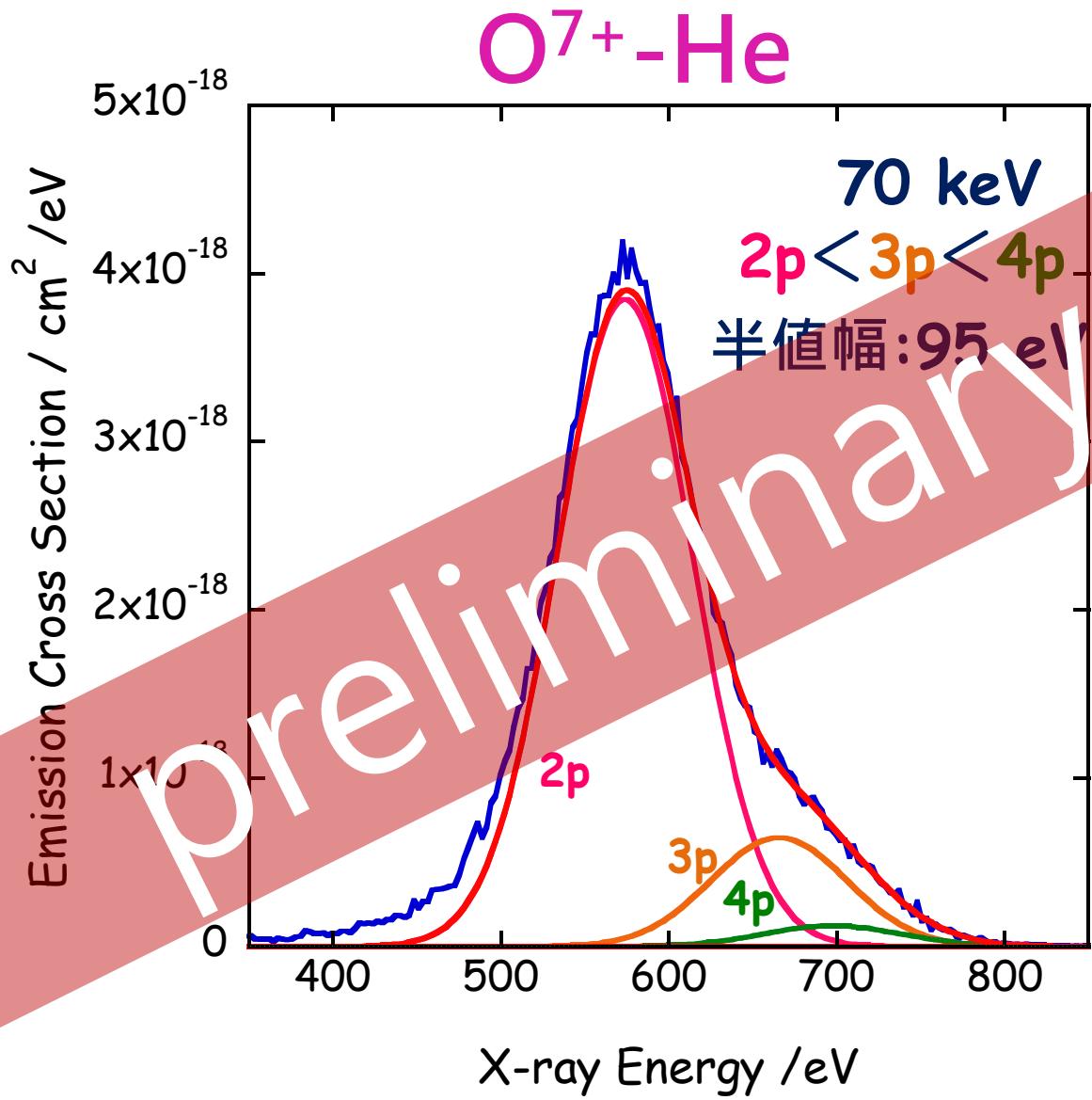


IP: H=CH₄=13.6 eV

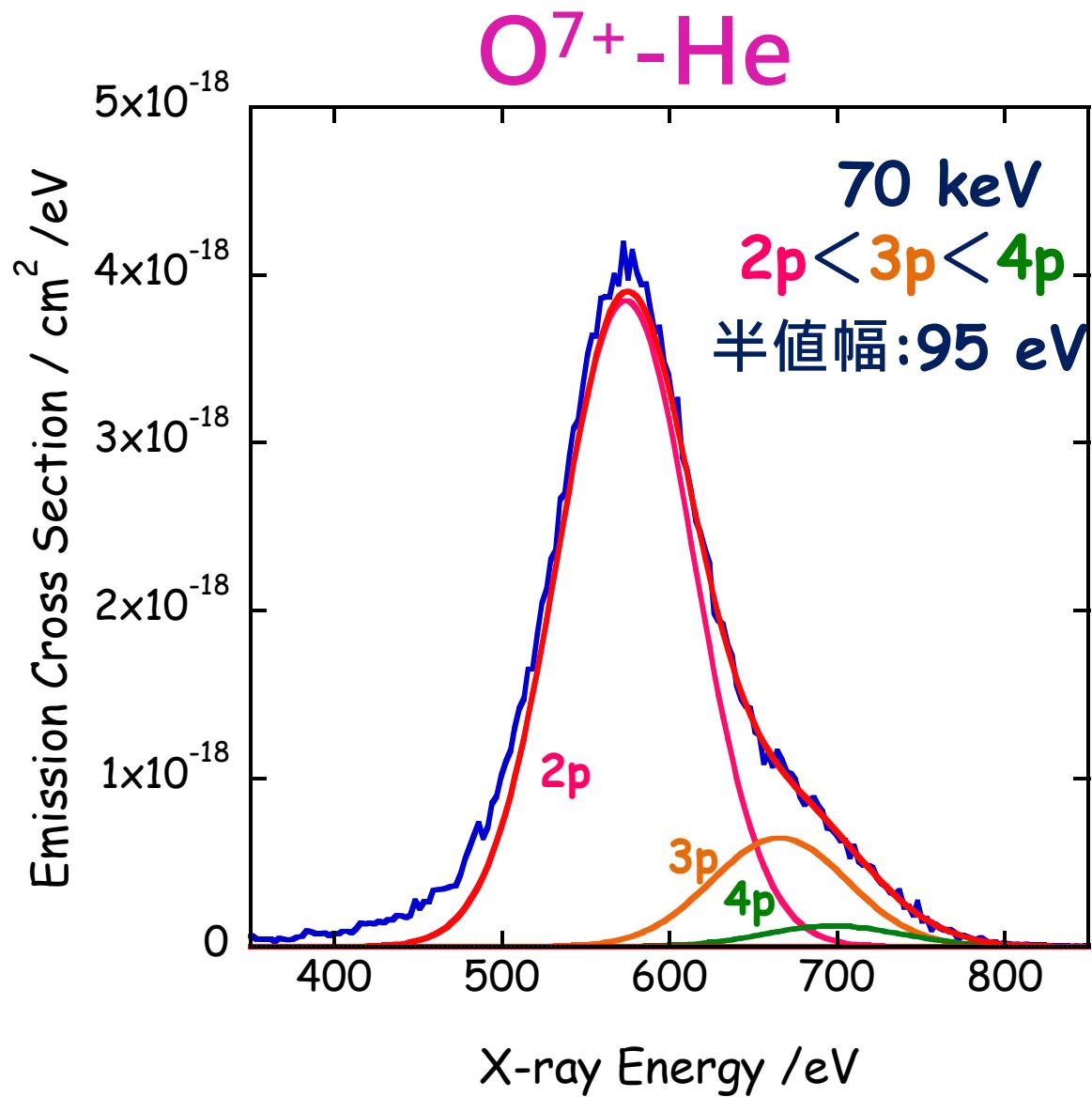


Collision Energy (keV)	Cross Section (cm ²)	Velocity (km/s)	error (%)
70	9.04×10^{-15}	919	17
63	7.99×10^{-15}	872	14
56	8.69×10^{-15}	822	12
52.5	6.09×10^{-15}	796	11
35	4.61×10^{-15}	650	23
28	4.24×10^{-15}	581	24
21	3.75×10^{-16}	503	28

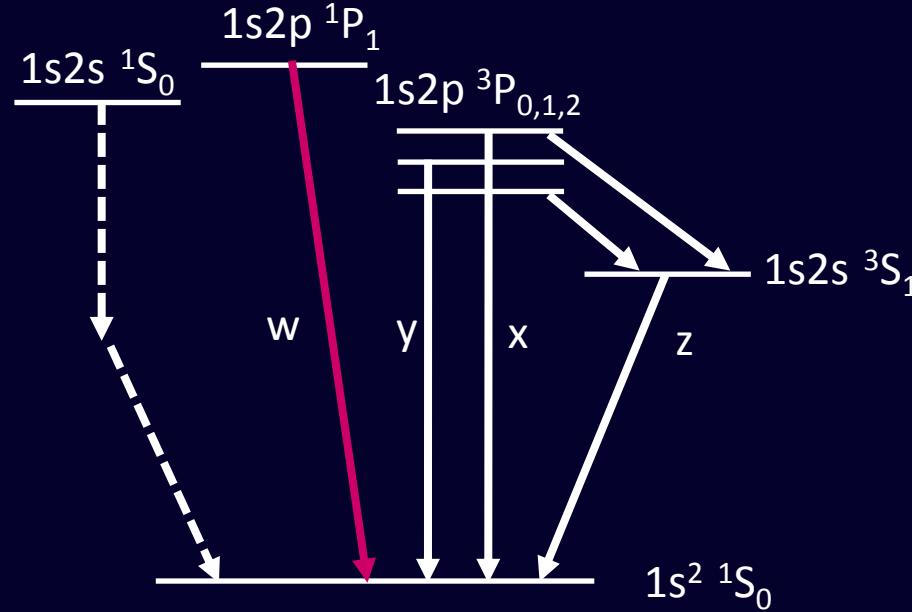
発光断面積



発光断面積

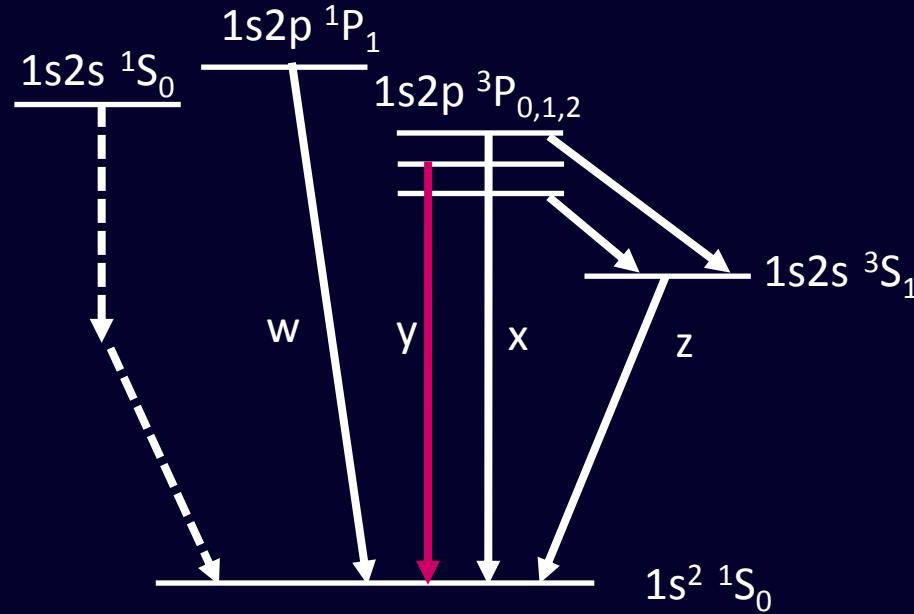


O⁶⁺ Schematic Diagram



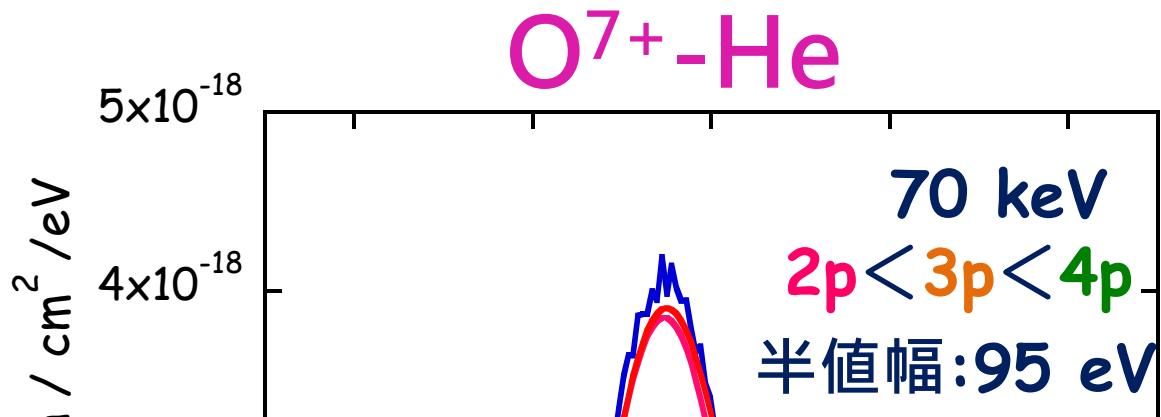
key	transition		wavelength (nm)	life time (s)	wavelength (nm)	life time (s)
		NIST	I.M. Savukov et al.			
w	$1s2p\ ^1P_1 \rightarrow 1s^2\ ^1S_0$	E1	2.1602	3.02×10^{-13}	2.1600	3.03×10^{-13}
x	$1s2p\ ^3P_2 \rightarrow 1s^2\ ^1S_0$	M2	2.1804	3.02×10^{-6}	2.1800	3.02×10^{-6}
y	$1s2p\ ^3P_1 \rightarrow 1s^2\ ^1S_0$	E1	-	-	2.1802	1.87×10^{-9}
z	$1s2s\ ^3S_1 \rightarrow 1s^2\ ^1S_0$	M1	2.2101	9.56×10^{-4}	2.2097	9.61×10^{-4}

O⁶⁺ Schematic Diagram

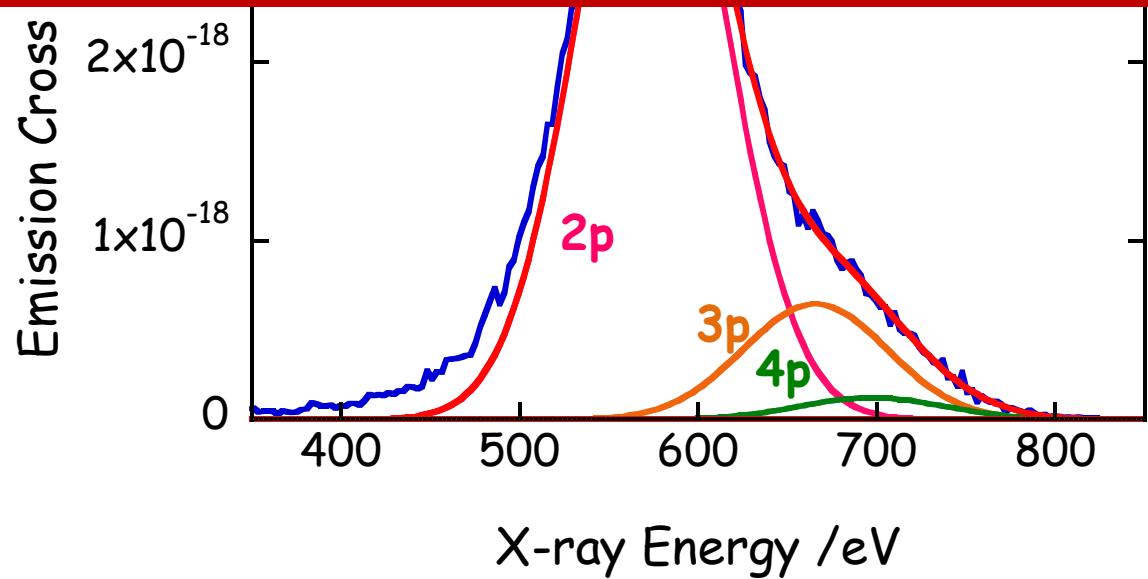


key	transition		wavelength (nm)	life time (s)	wavelength (nm)	life time (s)
			NIST		I.M. Savukov et al.	
w	$1s2p \ ^1P_1 \rightarrow 1s^2 \ ^1S_0$	E1	2.1602	3.02×10^{-13}	2.1600	3.03×10^{-13}
x	$1s2p \ ^3P_2 \rightarrow 1s^2 \ ^1S_0$	M2	2.1804	3.02×10^{-6}	2.1800	3.02×10^{-6}
y	$1s2p \ ^3P_1 \rightarrow 1s^2 \ ^1S_0$	E1	-	-	2.1802	1.87×10^{-9}
z	$1s2s \ ^3S_1 \rightarrow 1s^2 \ ^1S_0$	M1	2.2101	9.56×10^{-4}	2.2097	9.61×10^{-4}

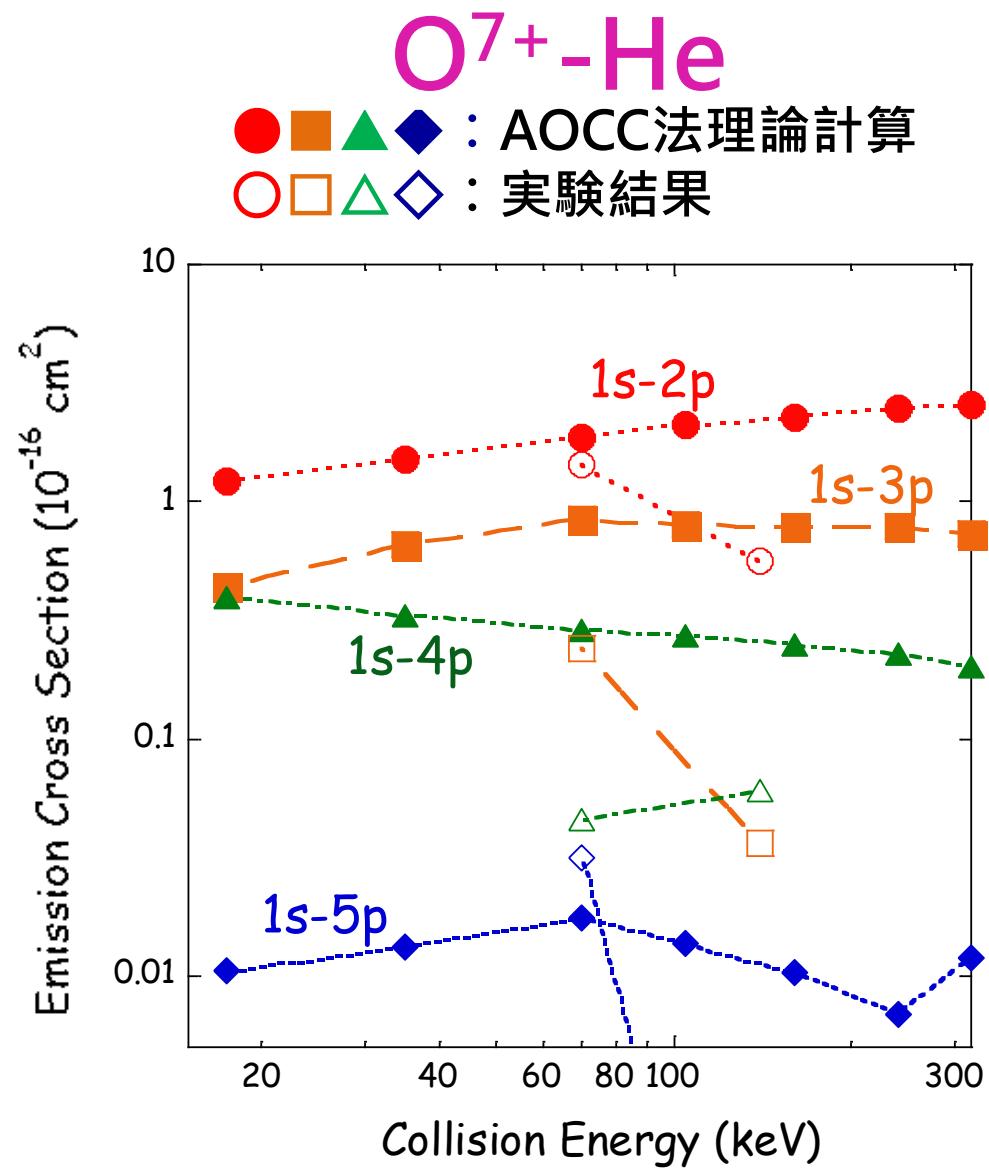
発光断面積



$3P_1$, $1P_1$ 両方からの発光が見える



発光断面積



まとめ

Projectile : C⁵⁺, O⁷⁺
Target : He, H₂, CH₄

- 電荷移行断面積の測定
いずれも過去のデータ、理論計算に一致

- 発光断面積の測定
等方散乱を仮定 / ³P₁, ¹P₁ の両方が発光

今後

- projectile : C⁶⁺, N⁷⁺, O⁸⁺
- Magic Angle 方向(54.7°)からの X 線観測
→ 偏光度に依存しない発光断面積の測定
- X 線集光レンズを用いた測定
- 準安定状態の発光を観測
→ kingdon trap の使用

発光断面積

$$\sigma[\text{cm}^2] = \frac{R[\text{/m}^3 \cdot \text{s}]}{n[\text{/m}^3] \cdot J[\text{/cm}^2 \cdot \text{s}]}$$

$$R[\text{/m}^3 \cdot \text{s}] = \boxed{n} \cdot \frac{4\pi r^2 [\text{mm}^2]}{\boxed{S [\text{mm}^2]}} \cdot \frac{1}{\boxed{t [\text{s}]}} \cdot \frac{1}{\boxed{4/3\pi r^3 [\text{m}^3]}}$$

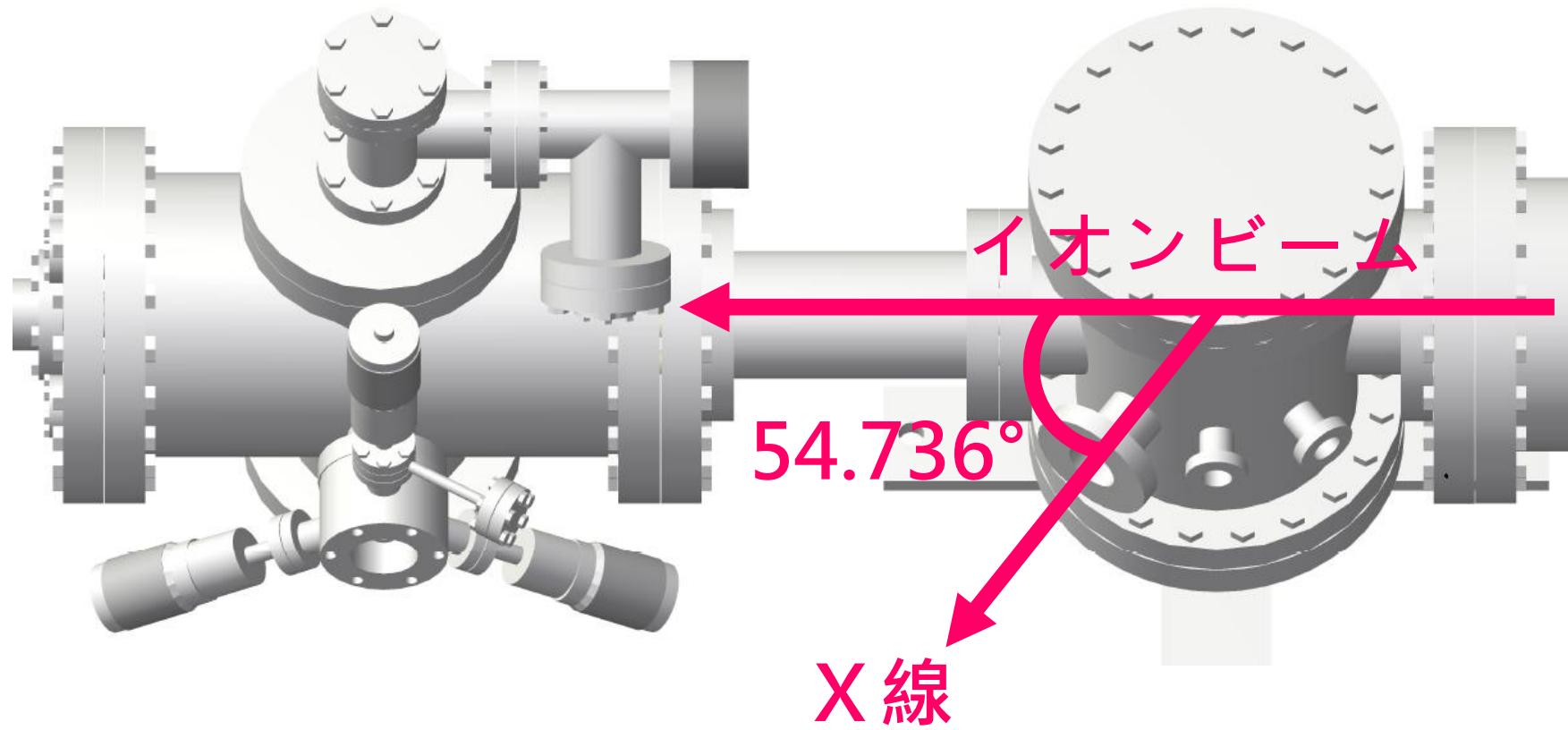
↓ solid angle ↓ emission volume
 number of event measurement time

$$J[\text{/cm}^2 \cdot \text{s}] = \boxed{I[A]} \cdot \boxed{e[A \cdot \text{s}]} \cdot \frac{1}{\boxed{q}} \cdot \frac{1}{\boxed{\pi r^2 [\text{cm}^2]}}$$

beam elementary
 current charge beam
 diameter
↓
 projectile charge

Magic angle

励起状態からの発光強度分布
→偏光度に依存しない発光強度



Magic angle

励起状態からの発光強度分布
→偏光度に依存しない発光強度

$$I(\theta) = \frac{1}{4\pi} [1 + \alpha_2 A_{20} P_2(\cos\theta)]$$

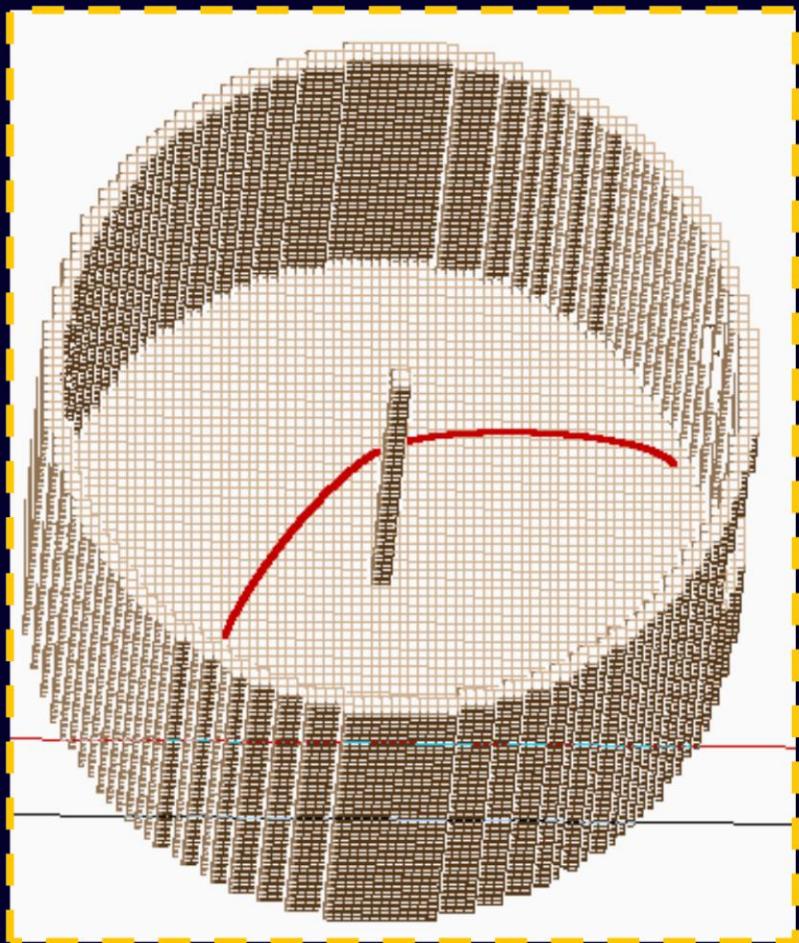
α_2 : 角運動量に依存するパラメータ

A_{20} : 偏光度に依存するパラメータ

$$P_2(\cos\theta) = 0 \Leftrightarrow 3\cos^2\theta - 1 = 0$$

$$\underline{\theta = 54.736^\circ}$$

~Kingdon Trap~



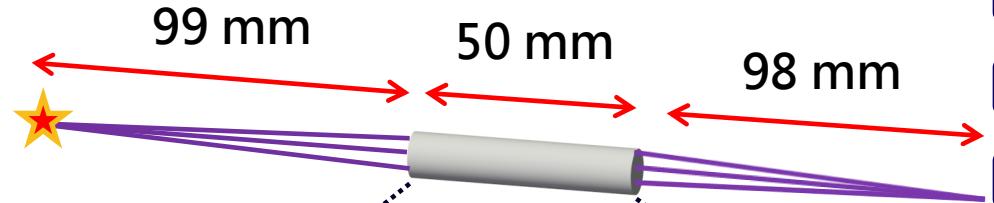
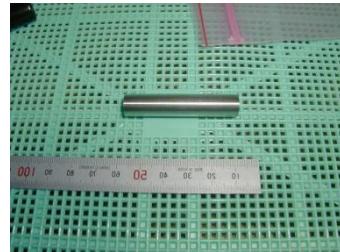
feature

- without the use of either magnetic fields or rf fields
- no potential minimum
- it consists of three electrodes
 - central wire
 - outer cylinder
 - two end caps
- dynamical stability

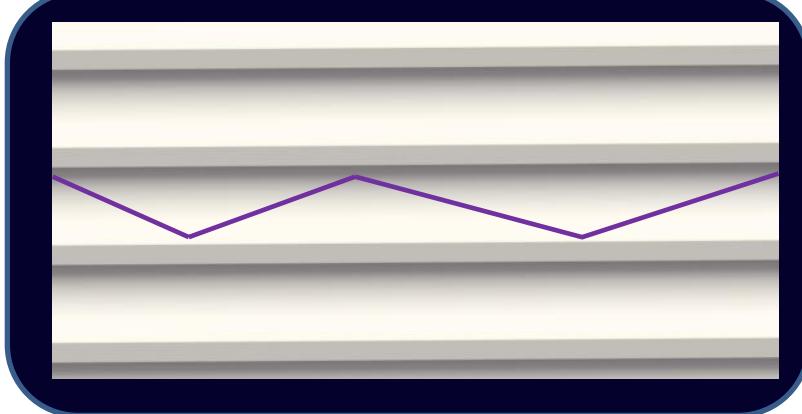
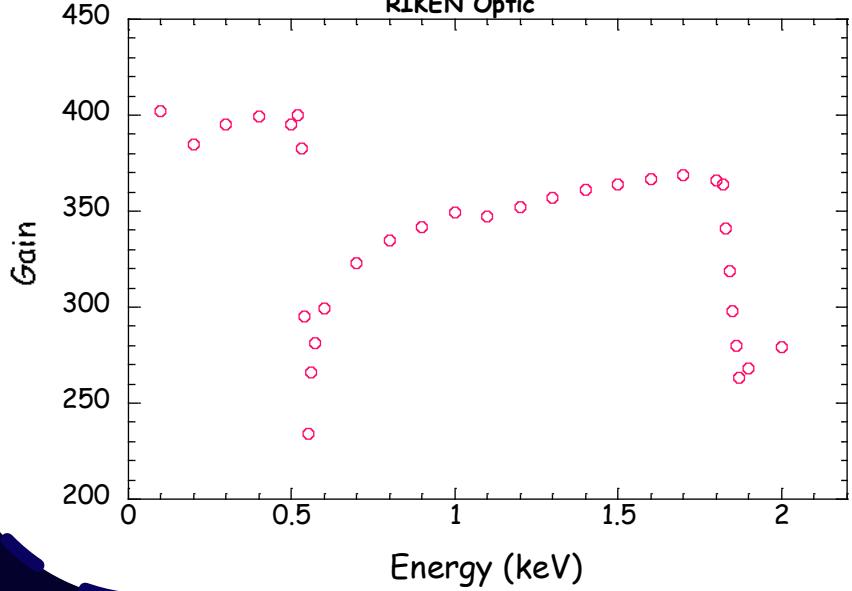


X 線 集 光 レ シ ズ

Polycapillary Optics FOR MICRO X-RAY FLUORESCENCE AND X-RAY DIFFRACTION

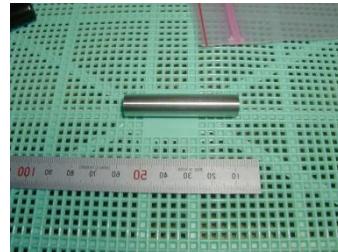


Gain vs. Energy (keV)
(Base case of 300μm pinhole 250mm away from a 500μm input source)
RIKEN Optic



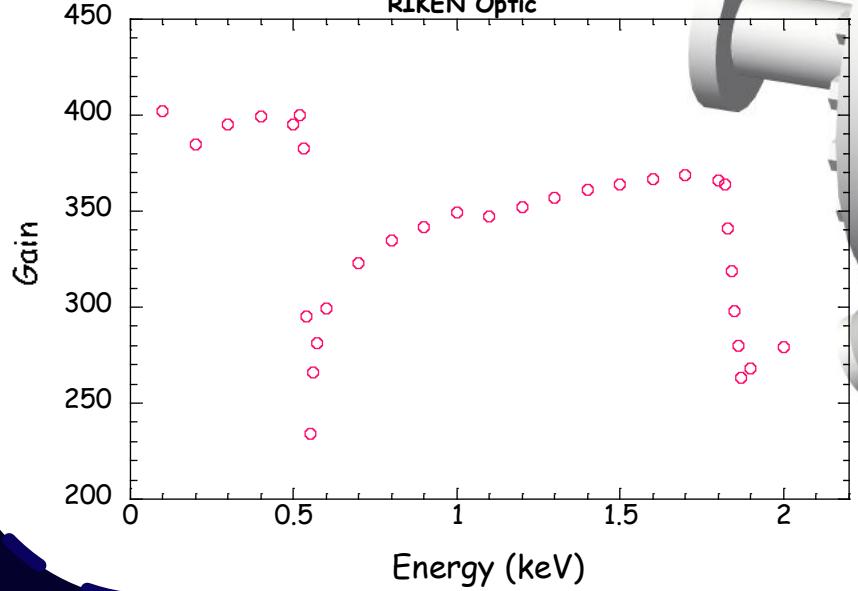
X 線 集 光 レ シ ズ

Polycapillary Optics FOR MICRO X-RAY FLUORESCENCE AND X-RAY DIFFRACTION



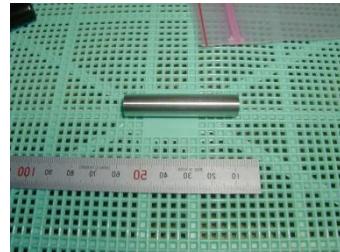
Gain vs. Energy (keV)

(Base case of 300um pinhole 250mm away from a 500um input source)
RIKEN Optic



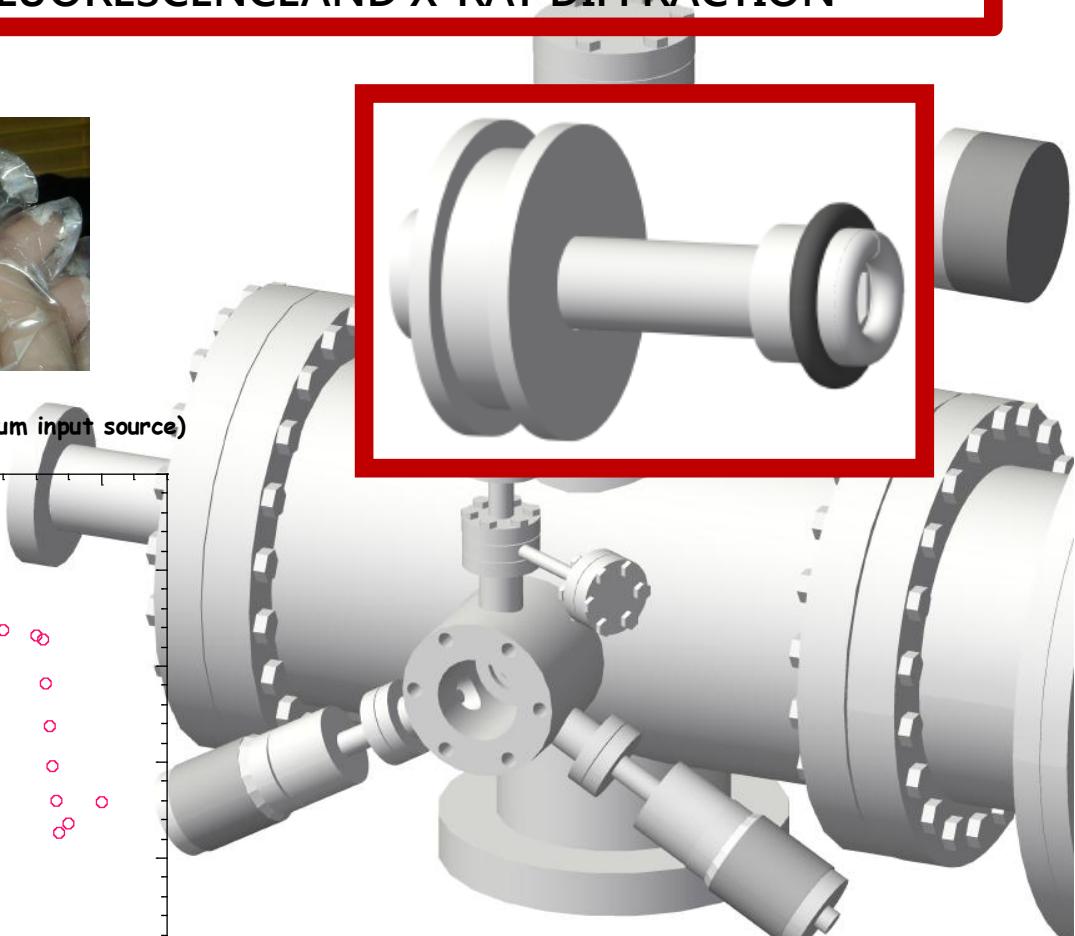
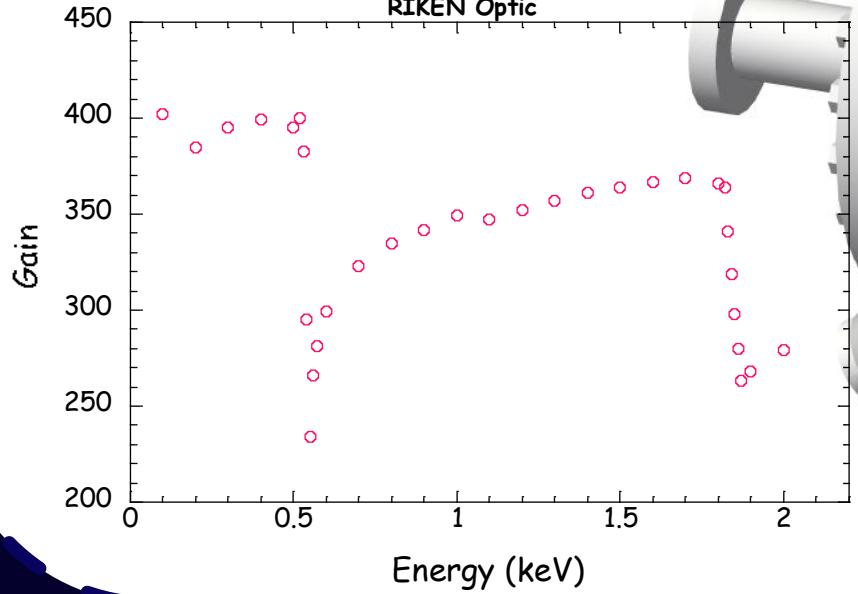
X 線 集 光 レ シ ズ

Polycapillary Optics FOR MICRO X-RAY FLUORESCENCE AND X-RAY DIFFRACTION



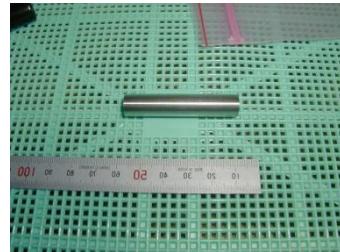
Gain vs. Energy (keV)

(Base case of 300um pinhole 250mm away from a 500um input source)
RIKEN Optic



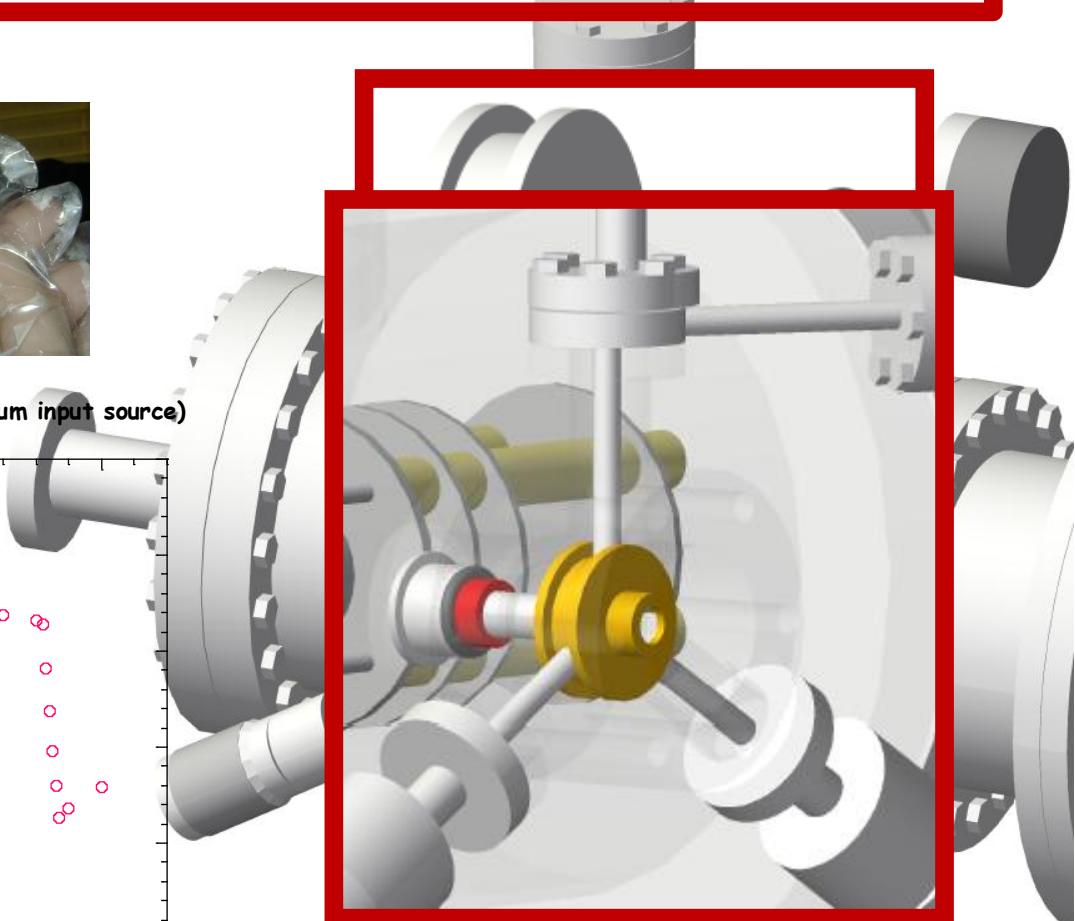
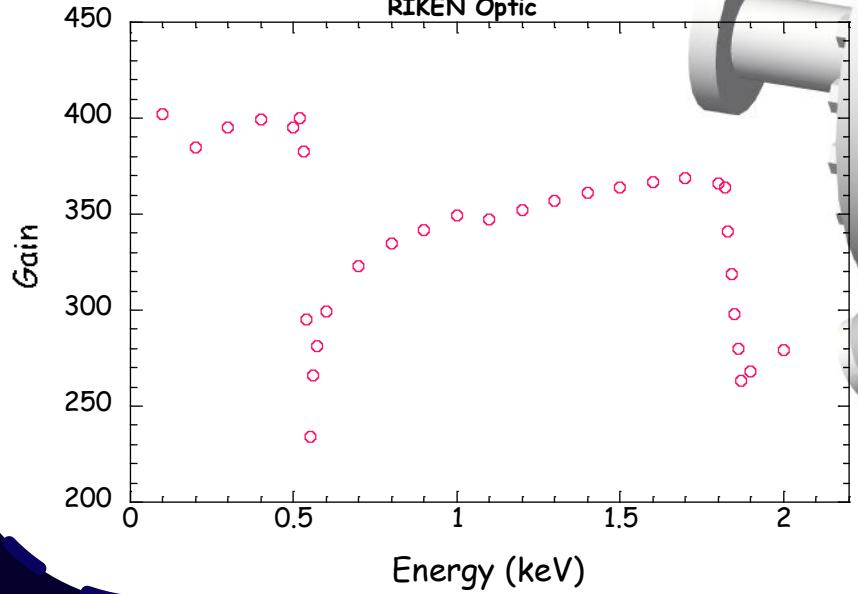
X 線 集 光 レ シ ズ

Polycapillary Optics FOR MICRO X-RAY FLUORESCENCE AND X-RAY DIFFRACTION

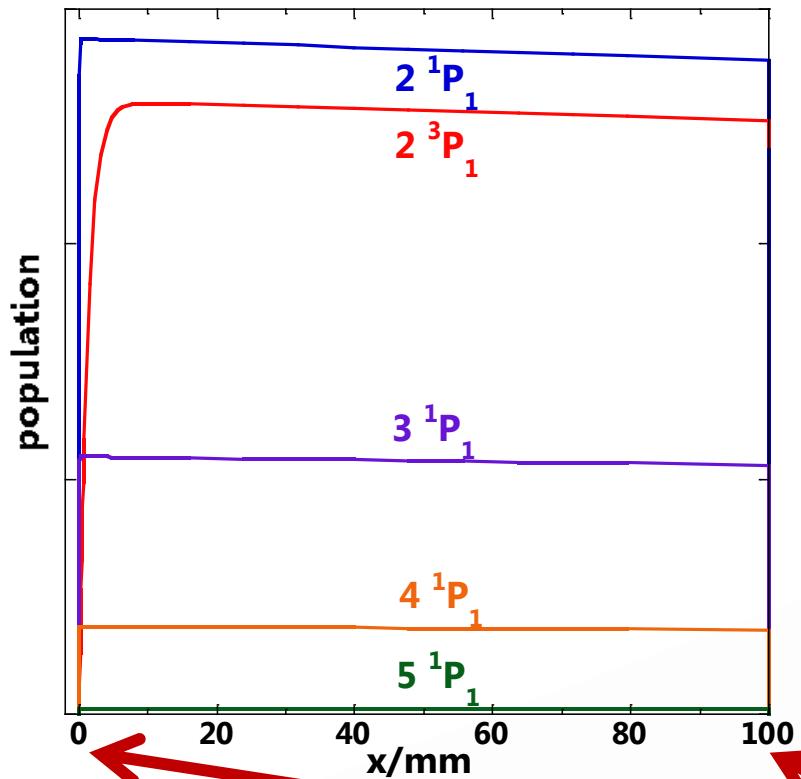


Gain vs. Energy (keV)

(Base case of 300um pinhole 250mm away from a 500um input source)
RIKEN Optic



3P₁ 状態からの発光



$$\frac{d[nls]}{dt} = \sigma v [\text{ion}] n - \sum_f A_{if}[nls] + \sum_i A_{if}[nl's']$$

[nls], [ion] : number density
 σ : charge transfer cross section
 by AOCC method (L. Liu)
 v : ion velocity
 n : number density of target gas
 A : Einstein coefficient

グラフの横軸は衝突セルの長さに対応

